

Silicon NPN Darlington Transistor

S730T

400V / 10A

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1985

S 730 T

Wärmewiderstand		Min.	Typ.	Max.	
Sperrschicht-Gehäuse	R_{thJC}			1.39	K/W
Kenngroßen					
$T_{case} = 25\text{ °C}$, falls nicht anders angegeben					
Kollektorruhestrom				300	μA
$U_{CE} = 400\text{ V}$	I_{CEO}			2	mA
$U_{CE} = 400\text{ V}$, $T_{case} = 125\text{ °C}$	I_{CEO}				
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung		400			V
$I_C = 2\text{ A}$, $L_C = 0.9\text{ mH}$, Fig. 1, 2, 3	$U_{(BR)CEO}$				
Kollektor-Sättigungsspannung				3	V
$I_C = 10\text{ A}$, $I_B = 0.4\text{ A}$	U_{CEsat}				
Kollektor-Basis-Gleichstromverhältnis		150			
$U_{CE} = 3\text{ V}$, $I_C = 5\text{ A}$	h_{FE}				
$I_C = 10\text{ A}$	h_{FE}	25			
Durchlaßspannung der integrierten Schutzdiode				1.8	V
$I_C = 10\text{ A}$	U_F				
Induktive Energie		200			mWs
$U_Z = 350\text{ V}$, $I_C = 7\text{ A}$, Fig. 4, 5	E_L				
Schaltzeiten					
$I_C = 5\text{ A}$, $I_{B1} = -I_{B2} = 50\text{ mA}$, $T_{case} = 25\text{ °C}$					
Abfallzeit	t_f		2	3	μs
Ausschaltzeit	t_{off}		8	20	μs

S 730 T

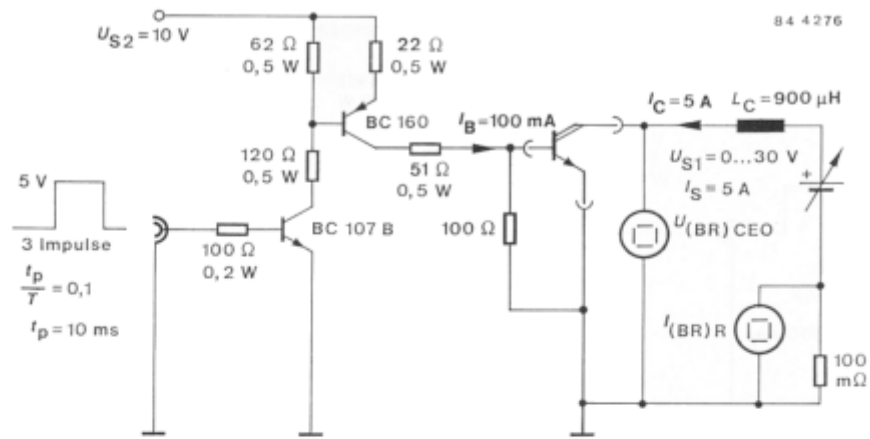


Fig. 1 Meßschaltung für: $U_{(BR)CEO}$

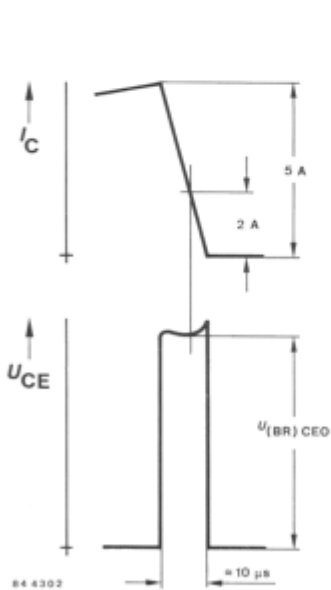
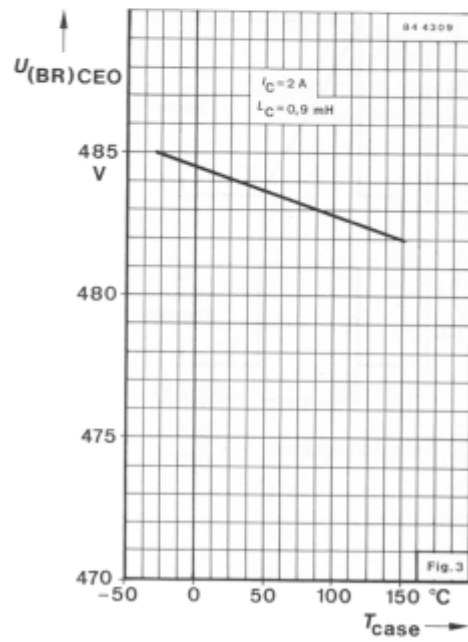


Fig. 2 Impulsdiagramm



S 730 T

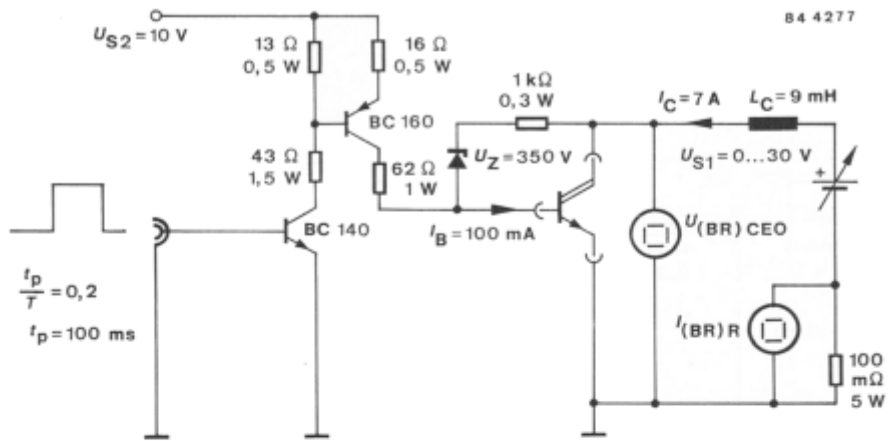


Fig. 4 Meßschaltung für: Induktiven Energietest

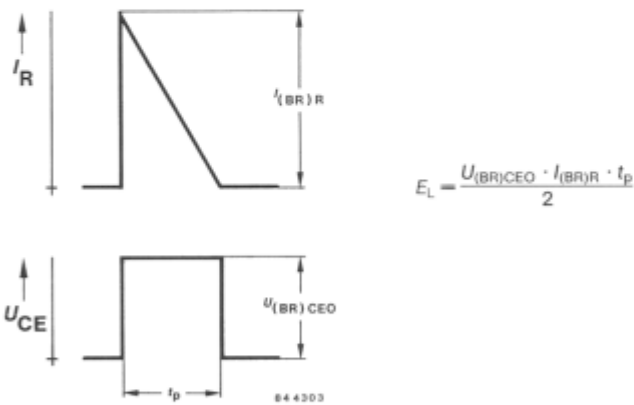


Fig. 5 Impulsdiagramm